～Hf系MONOS型トランジスタ～

☆1トランジスタ型不揮発メモリ

高速かつ低電圧動作が可能なユニバーサルメモリの創製を目的として、1トランジスタ型不揮発メモリに関する研究を進めている。本研究室では、フラッシュメモリの高性能化に向け、Hf系多層構造によるMONOS型多値メモリに関する研究を行っている。これは、従来用いられてきたフローティングゲート型メモリと比較して高誘電率であるhigh-k材料を各層に用いることによって、電気的な膜厚を低減し、より低電圧で高速に動作する。

